



SW-BUF01B 高性能模拟缓冲

特性

- 高精度：3mV
- 高转换率：500V/ μ s
- 高输出电流：50mA
- 高速应用的精密缓冲器

概述

SW-BUF01B 单元是单位增益缓冲器，能提供 50mA 纯源化电流或下降电流。转换率为 500 V/ μ s 可达到 3mV 的精度。该单元所占面积为 0.684 mm²。

直流电特性

(非特别注明, $V_S = \pm 5V$, $T_A = 25^\circ C$)

参数	测试条件 (s)	下限值	典型值	上限值	单位
输出失调电压	$V_{IN} = 0V$		± 3.0	± 5.0	mV
输入偏置电流	$V_{IN} = 0V$		5	10	μA
输入阻抗		0.5	0.8	2.0	M Ω
电压增益	$R_L = 600 \Omega$, $V_{IN} = \pm 1V$	0.994	0.997	1.000	V/V
输出阻抗	$R_L = 100 \Omega$, $V_{IN} = \pm 1V$	0.980	0.990	1.000	V/V
	$R_L = 100 \Omega$		0.003	0.1	Ω
输出电压摆率	$R_L = 100 \Omega$	± 2.5	± 3.0		V
电源抑制比	$V_{IN} = \pm 4V$ 到 $\pm 6V$	55	60		dB
电源电流	$R_L = \infty$		17.0	21.0	mA

SW- BUF01B 高性能模拟缓冲

直流电特性

($V_S = \pm 5.0V$, 在规定的温度范围)

参数	测试条件 (s)	下限值	典型值	上限值	单位
输出失调电压	$V_{IN} = 0V$		± 3.0	± 6.0	mV
输出电压漂移	$V_{IN} = 0V$		10	15	$\mu V/^\circ C$
输入偏置电流	$V_{IN} = 0V$		8	15	μA
输入阻抗		0.6	0.8	2.0	Meg
电压增益	$R_L = 600\Omega, V_{IN} = \pm 1V$	0.992	0.996	1.000	V/V
	$R_L = 100\Omega, V_{IN} = \pm 1V$	0.980	0.990	1.000	V/V
输出阻抗	$R_L = 100\Omega$		0.005	0.10	Ω
输出电压摆率	$R_L = 100\Omega$	± 2.5	3.0		V
电源抑制比	$V_S = \pm 4V$ 到 $\pm 6V$	50	60		dB
电源电流	$R_L = \infty$		20.0	24.0	mA

交流电特性

(非特别注明, $V_S = \pm 5V, T_A = 25^\circ C$)

参数	测试条件 (s)	下限值	典型值	上限值	单位
带宽 (-3dB)	$R_L = 100\Omega$	100	150		MHz
转换率	$V_{OUT} = \pm 2V$ (10%到 90%)	400	500		V/ μs
过冲			2		%
建立时间 (0.1%)			21	30	ns
传输延迟			1.0	1.5	ns
谐波失真	20Hz 到 20KHz	-74	-60		dB



西南集成电路设计有限公司

电话： (86 23) 62803074
(86 23) 62836154-8588
传真： (86 23) 62836149
网址： <http://www.swid.com.cn>
电邮： market@swid.com.cn